

通知

中華民國 110 年 11 月 29 日
聯絡人：楊弘道組長、何鴻裕專員
電話：2717162/傳真：2717165

- 一、本案係科技部 111 年度「次世代化合物半導體前瞻研發專案計畫」案，自即日起受理申請，依來文須於 111 年 1 月 26 日（星期三）前文抵科技部，請有意申請教師於 111 年 1 月 19 日（星期三）晚上 12 時前完成線上申請作業，並於 111 年 1 月 20 日（星期四）中午 12 時前列印申請書首頁送至本處彙辦。
- 二、本計畫目標為因應在電源、混合動力與電動車、5G/6G 高頻元件/系統等應用，將以國內矽基半導體和光電產業為基礎，擴展次世代化合物半導體領域，研究項目分成兩個分項，分項內容如下：
 - (一)5G/6G 高頻通訊關鍵半導體技術：專注於氮化鎵（GaN）、磷化銦（InP）於超高速的元件技術開發。
 - (二)下世代寬能隙高壓功率半導體技術：專注於氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）、氧化鎵（Ga₂O₃）及鑽石（Diamond）等寬能隙材料。
- 三、本計畫以單一整合型計畫為限，每一整合型計畫之總計畫及所有子計畫全部書寫於一份計畫書，子計畫應為 3 個（含）以上，最多以不超過 6 個為原則。總計畫主持人須同時主持 1 項子計畫，各主持人應實質參與研究，計畫書應詳實註明各主持人負責之研究主題，整合之計畫需有整體明確的目標，並由總計畫主持人之服務機關提出申請。本計畫申請人應規劃四年（111 年 5 月 1 日至 115 年 4 月 30 日止），採分年核定多年期計畫方式辦理，每年度申請總額度以不超過 2,200 萬元為原則。
- 四、本案相關申請詳細資訊請參閱徵求公告。
- 五、檢送來文及相關附件如附檔，請各單位協助轉知所屬知悉。

此致
各學院

研究發展處敬啟